# Výzkumné centrum CEITEC a magnetické vrstvy a supermřížky



### Osnova přednášky

 výzkumné centrum CEITEC a přehled jeho vybavení

 princip pulsní laserové depozice a růst SrTiO<sub>3</sub>-LaFeO<sub>3</sub> supermřížek

• princip spektroskopické elipsometrie

 výzkum elektronových vlastností feromagnetických vrstev La<sub>1-x</sub>Sr<sub>x</sub>CoO<sub>3</sub> pomocí elipsometrie









## CEITEC - nové vědecké centrum v Brně zaštiťované VUT a MU



- nové meziuniverzitní vědecké centrum v Brně, účast VUT a MU
- velké investice do vědecké infrastruktury díky EU (~ 2 mld. Kč)
- možnost přístupu studentů ke špičkovému vybavení a zapojení do výzkumu již od bakalářských prací

# Depozice a analýza vzorků v ultravysokém vakuu (UHV klastr)



depoziční přístroje:

- pulsní laserová depozice (PLD)
- epitaxe molekulárních svazků (MBE)
- depozice organických a kovových materiálů (MBE organika)

analytické přístroje:

• PES fotoemisní spektroskopie: XPS, UPS

SPECS

- skenovací mikroskop (SPM)
- elektronový mikroskop na nízkých energiích (LEEM)
- spektr. s ionty na nízkých energiích (LEIS)

# Špičkové vybavení ve výzkumné infrastruktuře CEITEC nano

#### nízkoteplotní IČ elipsometrie (7-400 K)



#### Magnetické a transportní měření 1.6 – 400 K, 9 T





#### nízkoteplotní elipsometrie ve VIS-UV



# Špičkové vybavení ve výzkumné infrastruktuře CEITEC nano

#### Rentgenová analýza (5-1400 K)



#### Transmisní elektronový mikroskop Titan



#### Mikroskopie - AFM



#### Elektronová a UV litografie



# Pulsní laserová depozice (PLD)



- PLD vybavené špičkovou současnou technologií
- tlak 5x10<sup>-10</sup> mbar
- kontrola růstu s RHEED
- in situ ozonová atmosféra
- ultra homogenní růst se skenováním laserového svazku
- připojené na UHV klastr s analytickými metodami (XPS, ARPES, LEEM, LEED, STM

7

## Princip pulsní laserové depozice





Možnost kombinovat až 5 materiálů a růst multivrstvy - supermřížky



#### V. K. Malik et al, PRB 2012

 kontrola růstu monovrstev pomocí RHEEDu:



# vývoj RHEEDového signálu při růstu jedné monovrstvy



laskavé svolení C. Bernharda

## Růst SrTiO<sub>3</sub> (diplomová práce M. Kiaby)





obraz RHEED před depozicí



4

2.0 nm

1.5

1.0

0.5

0.0

obraz RHEED po depozici

# Současný projekt: elektronové stavy v LaFeO<sub>3</sub>/SrTiO<sub>3</sub> supermřížkách

- Cíl: vytvořit supermřížky na atomární úrovni (1-2 monovrstvy) z antiferomagnetického izolátoru LaFeO<sub>3</sub> ( $T_{\text{Neel}}$  = 700 K) a izolantu SrTiO<sub>3</sub>
- La<sub>0.5</sub>Sr<sub>0.5</sub>FeO<sub>3</sub> je vodivý kov, tedy rozhraní LaFeO<sub>3</sub> a SrTiO<sub>3</sub> můžou být vodivá

 systém bude vykazovat základní elementy vysokoteplotní supravodivosti v kuprátech: blízkost k antiferomagnetickému stavu a dvoudimenzionální vodivé roviny



# elektronové stavy v LaFeO<sub>3</sub>/SrTiO<sub>3</sub> supermřížkách: první výsledky



(včerejší) depozice LaFeO<sub>3</sub> M. Kiaby (univerzita Twente, Holandsko)



#### **Princip elipsometrie**



 Elipsometrie je de facto interferenční experiment s komponentou elektrického pole rovnoběžnou (p) a kolmou (s) k rovině dopadu.

#### Měřené veličiny v elipsometrii:

- úhel pootočení elipsy  $\Psi$
- elipticita  $\Delta$

=>

Reálná a imag. část dielektrické funkce  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$ 

# Elipsometrické vybavení v institutu 🌮 🤇 🖛

Woollam VASE, (190nm-2.5 μm) He kryostat 7-400 K



P. Friš *et al.* Phys. Rev. B **97**, 045137 (2018).
P. Friš and A. Dubroka, Appl. Surf. Sci., **421**, 430 (2017).
C.N. Wang *et al.* Appl. Surf. Sci **421**, 859 (2017)
P. Friš and A. Dubroka, Appl. Surf. Sci., **421**, 430 (2017).
O. Caha *et al.* Appl. Phys. Lett. 103,202107 (2013)

Woollam IR-VASE, (2.5-30  $\mu$ m)



Ellipsometer do vzdálené IČ oblasti (50-700 cm<sup>-1</sup>)



#### Opticky aktivní excitace mezi terahetzovým a ultrafialovým oborem



16

## Optická vodivost feromagnetických kobaltátů

 $La_{0.7}Sr_{0.3}CoO_3, T_c \sim 205 K$ Reálná část optické vodivosti,  $\sigma_1(\omega) = \omega \varepsilon_0 \varepsilon_2(\omega)$ , je přímo úměná absorpci záření na jednotku frekvence (a) 8000 8000 a) *T*=7 K b) *T*=220 K ----- data 6000 6000 fit  $\odot$ Drude 1 <sup>0</sup>\_1 [O\_1 cm<sup>-1</sup>] — Drude 2  $σ_1 [\Omega^{-1} cm^{-1}]$ Drude 3 4000 Lorentzian 2000 La,Sr • 2000 Со  $\bigcirc$ Ο 0 3 0 2 3 0 Photon Energy [eV] Photon Energy [eV]  $\epsilon(\omega) = 1 - \sum_{i} \frac{\omega_{D,j}^{2}}{\omega(\omega + i\gamma_{D,j})} + \sum_{k} \frac{\omega_{L,k}^{2}}{\omega_{0k}^{2} - \omega^{2} - i\omega\gamma_{L,k}}$  Modelování vodivosti Drude-Lorentzovým modelem:

nutno použít vícero Drudeho členů:- pravděpodobně znak vícepásové vodivosti<sup>17</sup>

## Optické znaky feromagnetického stavu



18

## Optické znaky feromagnetického stavu

#### La<sub>0.7</sub>Sr<sub>0.3</sub>CoO<sub>3</sub>, *T*<sub>c</sub> ~205 K

• Spektrální váhy (integrál z  $\sigma_1$ ) od Drudeho píku a pásu na 1.5 eV sledují magnetizaci vzorku - jsou teda spojeni s feromagnetickým přechodem

Konkrétněji přesuny odpovídají tzv. dvojné výměnné interakci



19 P. Friš *et al.*, PRB **97**, 045137 (2018)

## Přechody elektronů mezi kobalty



přeskoky mezy kobalty s antiparalelním spinem (přechod se "špatným spinem")
tento přechod porušuje Hundova pravidla a je potřeba na něho energii (v tomto případě ~1.5 eV)

20

# Současný výzkum: elektronové vlastnosti feromagnetu La<sub>1-x</sub>Sr<sub>x</sub>CoO<sub>3</sub> v závislosti na dopování Sr

• elektronová struktura (Drude a "wrong spin transition") feromagnetického stavu v  $La_{1-x}Sr_xCoO_3$  v závislosti na koncentraci děr x. Evoluce z izolujícího stavu (x=0) do feromagnetu (x>0)



• dopování x=0.5, 0.7, a 0.2

# Děkuji za pozornost

# dodatky

### P. Klenovský, výpočty elektronových stavů kvantových teček: Ukázka: kvantové tečky GaAs/InAs/GaAs<sub>1-v</sub>Sb<sub>v</sub>



P. Klenovský et al, PRB 100 115424 (2019)
P. Klenovský et al, PRB 97 542 (2018)
P. Klenovský et al, PRB 96 045414 (2017)

## **Optická vodivost**

Optická vodivost se pojí s dielektrickou funkcí:  $\sigma(\omega) = -i\omega\varepsilon_0(\varepsilon(\omega) - 1)$ 

Je to komplexní funkce podobně jako diel. funckce:  $\sigma(\omega) = \sigma_1(\omega) + i\sigma_2(\omega)$ 

• Reálná část vodivosti,  $\sigma_1(\omega) = \omega \epsilon_0 \epsilon_2(\omega)$ , je přímo úměná absorpci záření na jednotku frekvence

•  $\sigma_1 (\omega=0) = \sigma_{DC}$ 

• pro  $\sigma_1$  existuje sumační praviedlo

$$\int_{0}^{\infty} \sigma_{1}(\omega) \mathrm{d}\omega = \frac{\pi n q^{2}}{2\varepsilon_{0} m} = \text{constant}$$

- Integrál z  $\sigma_1(\omega)$  přes určitý frekvenční obor je úměrný koncentraci náboje způsobující absorpci

#### základní rovnice elipsometrie

Definice elipsometrických úhlů 
$$\Psi$$
 a  $\Delta$ :  $\rho = \frac{r_{\rm p}}{r_{\rm s}} = \, {\rm tan} \, \Psi \, {\rm e}^{{\rm i}\Delta}$ 

Fresnelovy koeficienty:

$$r_{\rm p} = \frac{N_2 \cos \theta_1 - N_1 \cos \theta_2}{N_1 \cos \theta_2 + N_2 \cos \theta_1} \quad r_{\rm s} = \frac{N_1 \cos \theta_1 - N_2 \cos \theta_2}{N_1 \cos \theta_1 + N_2 \cos \theta_2}$$

Snellůlv zákon:  $N_1 \sin \theta_1 = N_2 \sin \theta_2$ 

Index lomu okolí:  $N_1=\sqrt{\epsilon_{
m a}}$  Index lomu vzorku:  $N_2=\sqrt{\epsilon_{
m s}}$ 

Inverzí výše uvedených rovnic obdržíme v případě polonekonečného izotropního vzorku explicitní analytický výraz pro dielektrickou funkci (jak její reálnou tak i imaginární část):

$$\epsilon_{\rm s}(\Psi, \Delta) = \epsilon_{\rm a} \sin^2 \theta_1 \left( 1 + \tan^2 \theta_1 \left( \frac{1 - \rho(\Psi, \Delta)}{1 + \rho(\Psi, \Delta)} \right)^2 \right)$$

shrnuto: ze dvou měřených veličin  $\Psi$  a  $\Delta$  určíme dvě veličiny  $\epsilon_1$  a  $\epsilon_2$ 

#### Lorentzův oscilátor

Newtonova rovnice harmonicky buzeného mechanického oscilátoru:

$$m\frac{\mathrm{d}^{2}x(t)}{\mathrm{d}t^{2}} = -k\,x(t) - m\gamma\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + qE_{0}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega \mathrm{t}}$$

$$\mathbf{\check{R}e\check{s}eni:} \qquad x_{0}(\omega) = \frac{F}{\omega_{0}^{2} - \omega^{2} - \mathrm{i}\omega\gamma}$$

$$(1 - \omega)\sqrt{k} = \frac{qE_{0}}{\omega_{0}}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} , \quad F = \frac{qE_0}{m}$$

polarizace je hustota dipólového momentu

$$P(\omega) = \sum_{j} nqx_{0,j}(\omega)$$
 n: koncentrace

z definice dielektrické funkce:

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{P(\omega)}{\varepsilon_0 E(\omega)} = 1 + \sum_j \frac{\omega_{pl,j}^2}{\omega_{0,j}^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_j}$$

příspěvek vysokofrekvenčních přechodů lze nejhruběji aproximovat konstantou:

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_{\infty} + \sum_{j} \frac{\omega_{\mathrm{pl},j}^2}{\omega_{0,j}^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\omega\gamma_j}$$

 dielektrická fukce nezávislých Lorentzových oscilátorů. Typicky dobře funguje pro fonony. Drudeův model kozvů dostaneme dosazením  $\omega_0=0$ 



plasmová frekvence:

 $\omega_{\mathrm{pl},j} = \sqrt{\frac{q_j^2 n_j}{\epsilon_0 m_j}}$ 

# ukázka: IČ Reflektivita LiF



# Drudeova formule

• odezvu volných nosičů náboje získáme pro  $\omega_0$ =0

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_{\infty} - \frac{\omega_{pl}^2}{\omega(\omega + i\gamma)}$$

plasmová frekvence

$$\omega_{pl} = \sqrt{\frac{q^2 n}{\varepsilon_0 m^*}}$$

závisí na koncentraci nositelů n a na jejich efektivní hmotnosti  $m^*$ 

 $\varepsilon_1$  prochází nulou (pro  $\gamma \sim 0$ ) pro

$$\omega = \frac{\omega_{pl}}{\sqrt{\varepsilon_{\infty}}}$$

pro  $\varepsilon_{\infty} = 1$  je to přímo  $\omega_{pl}$ . Na této frekvenci se v látce propaguje longitudinální plasmon, proto se této frekvenci říká plasmová.

#### Ukázka dielektrické funkce n-dopovaného křemíku



#### **Drude model**

A classical model of dielectric response of free and *mutually non-interacting* charge carriers

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_{\infty} - \frac{\omega_{\rm pl}^2}{\omega(\omega + i\gamma)}$$

where 
$$\omega_{pl}$$
 is the plasma frequency  $\omega_{pl} = \sqrt{\frac{q^2 n}{\varepsilon_0 m^*}}$ 

Example on n-doped silicon:

